



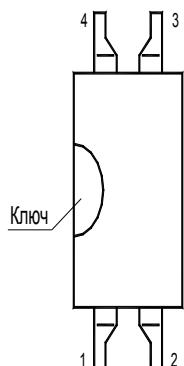
Россия, г. Орел, ОАО "Протон"

**Микросхемы интегральные  
КР249КН4А+П**

**Э Т И К Е Т К А**

Микросхемы интегральные гибридные КР249КН4А+П предназначены для работы в качестве коммутатора с электрической изоляцией между входными и выходными выводами микросхемы.

**Схема расположения выводов**



**Таблица назначения выводов**

Номер вывода	Назначение вывода
1	Анод излучающего диода
2	Катод излучающего диода
3	Коллектор транзистора
4	Эмиттер транзистора

**Основные электрические параметры**

Тип микросхемы	Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквен. обозначение	Норма		Температура, °C
			не менее	не более	
1	2	3	4	5	6
КР249КН4А,Б,В,Г	Выходное остаточное напряжение, В I <sub>bx</sub> = 10 мА, I <sub>ком</sub> = 2 мА	U <sub>вых.ост</sub>		0,8	от минус 45 до 70
КР249КН4Д,Е,Ж,И				0,6	
КР249КН4К,Л,Н,П				0,4	
КР249КН4А,Б,В,Г,Д,Е,Ж, И,К,Л,Н,П	Входное напряжение, В I <sub>bx</sub> = 10 мА	U <sub>bx</sub>		1,8	от минус 45 до 70
КР249КН4А,Б,В,Г	Ток утечки на выходе, мкА U <sub>ком</sub> = 200В	I <sub>ут.вых</sub>		10	25
КР249КН4Д,Е,Ж,И				100	70
КР249КН4К,Л,Н,П				10	25
КР249КН4К,Л,Н,П				100	70
КР249КН4А,Б,В,Г, Д,Е,Ж,И	Коэффициент передачи по току U <sub>ком</sub> = 10В, R <sub>h</sub> = 2,5кОм, I <sub>bx</sub> = 10mA	k <sub>i</sub>	0,2		от минус 45 до 70
КР249КН4К,Л,Н,П	U <sub>ком</sub> = 10В, R <sub>h</sub> = 1,2кОм, I <sub>bx</sub> = 10mA		0,5		

1	2	3	4	5	6
KP249KH4A,Б,В,Г, Д,Е,Ж,И	Время задержки распространения сигнала при включении и выключении, мкс R <sub>H</sub> = 5кОм, I <sub>ВХ.и</sub> = 10mA, U <sub>КОМ</sub> =10В, f =10кГц, τ <sub>ВХ и</sub> =5мкс, τ <sub>Ф.ВХ</sub> =τ <sub>СП.ВХ</sub> =0,1мкс	t <sup>1,0</sup> <sub>3д.р</sub>		5	25
KP249KH4К,Л,Н,П	R <sub>H</sub> = 100 Ом, I <sub>ВХ.и</sub> = 10mA, U <sub>КОМ</sub> =10В, f =10кГц, τ <sub>ВХ и</sub> =5мкс, τ <sub>Ф.ВХ</sub> =τ <sub>СП.ВХ</sub> =0,1мкс	t <sup>0,1</sup> <sub>3д.р</sub>		4	
KP249KH4К,Л,Н,П	R <sub>H</sub> = 1кОм, I <sub>ВХ.и</sub> = 10mA, U <sub>КОМ</sub> =10В, f =10кГц, τ <sub>ВХ и</sub> =50мкс, τ <sub>Ф.ВХ</sub> =τ <sub>СП.ВХ</sub> =0,1мкс			15	
KP249KH4A,Б,В,Г, Д,Е, Ж,И,К,Л,Н,П	Проходная емкость, пФ	Спр		5	25
KP249KH4A,Б,В,Г, Д, Е, Ж,И,К,Л,Н,П	Сопротивление изоляции, Ом U <sub>из</sub> = 500В	Риз	1x10 <sup>12</sup>		25
KP249KH4A, Д, К Б, Е, Л В, Ж, Н Г, И, П	Напряжение изоляции, В	U <sub>из</sub> *	5000 3000 1500 500		25

**Примечание:** \* В течение 1 мин. при относительной влажности воздуха ≤ 50%.

Контролируемый ток не должен превышать 10мкА.

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем.

Золото \_\_\_\_\_ г

Серебро \_\_\_\_\_ г

На выводах драгоценных металлов не содержится.

Цветных металлов не содержится.

### С В Е Д Е Н И Я О П Р И Е М К Е

Микросхемы интегральные KP249KH4 соответствуют техническим условиям АДБК.4311.60.344ТУ.

Штамп ОТК

### Указания по применению и эксплуатации.

Допустимое значение статического потенциала - 500В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки при температуре не выше 265°C продолжительностью не более 3с.

Число допустимых перепаек выводов микросхем при проведении монтажных (сборочных) операций не более 2.

Режим и условия монтажа микросхем в аппаратуре – по ОСТ 11 073.063.

Допускается воздействие обратного напряжения на вход микросхемы с амплитудой не более 3,5В, длительностью не более 10мкс.

Маркировка микросхем:

тип изделия – КН4

типономинал - А,Б,В,Г, Д,Е, Ж,И,К,Л,Н,П